

電漿輔助式原子層沉積系統

(PLASMA-ENHANCED ATOMIC LAYER DEPOSITION)

儀器簡介

電漿輔助式原子層沉積系統主要功能在於沉積高介電常數薄膜,可隨著 precursor 的更換,而沉積出不同種類的薄膜。目前所能沉積的薄膜以 HfO_2 及 Al_2O_3 薄膜,且製程厚度為 20~100Å 的薄膜。

- ❖ 全名: 電漿輔助式原子層沉積系統
- ❖ 位置: class 10000
- ❖ 機台工程師: 邱文政 先生
- ❖ 工程師緊急聯絡電話: (O) 03-5726100 ext 7569
- ❖ 工程師代理人: 陳品光 先生
- ❖ 代理工程師緊急聯絡電話: (O) 03-5726100 ext 7651
- ❖ 機台使用之化學品:
 - (1) 大宗氣體: $\text{N}_2, \text{Ar}, \text{O}_2,$
 - (2) 特殊氣體:
 - (3) 瓶裝化學品: 金屬有機化合物,
- ❖ 製程模式或反應腔: Plasma mode
- ❖ 反應腔真空度範圍: $5\text{e-}2$ torr
- ❖ 抽真空泵浦: Oil pump
- ❖ 尾氣排放物種: C, N, O,
- ❖ 尾氣排放有無獨立之 Local Scrubber: 有, 廠務端提供
- ❖ 反應腔溫度範圍: $250\sim 400^\circ\text{C}$
- ❖ 冷卻系統種類: 廠務供應冷卻水
- ❖ 其他特殊危害: 如有機化合物或氣體等等
- ❖ 製造商或代理商: 矽基科技
- ❖ 代理商工程師: 葉培享, Tel: 03-5574282
- ❖ 更新日期: 3 (月)/ 23 (日)/ 2018 (年)